



2SB926 (3CG926)

硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途:用于电源供应, 继电器驱动, 灯驱动器等电子设备。

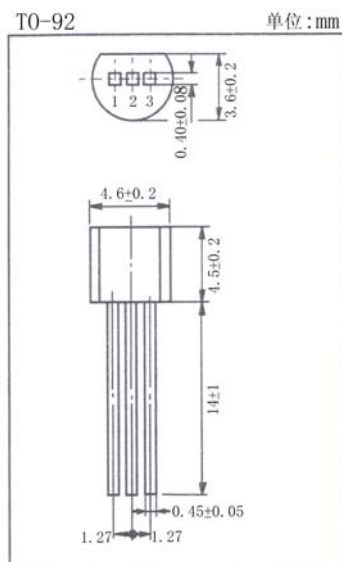
Purpose: Power supplies, relay drivers, lamp drivers, electrical equipment.

特点:采用 FBET 和 MBIT 工艺, 饱和压降低, 电流容量大和宽阔的安全工作区。

Features: Adoption of FBET, MBIT processes, low saturation voltage, large current capacity and wide ASO.

极限参数/Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V _{CB0}	-30	V
V _{CE0}	-25	V
V _{EBO}	-6.0	V
I _C	-2.0	A
I _{CP}	-5.0	A
P _C	0.75	W
T _j	150	°C
T _{stg}	-55~150	°C



引脚: 1. E 2. C 3. B

电性能参数/Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数符号 Symbol	测试条件 Test Condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V _{CB0}	I _C =-10 μ A I _E =0	-30			V
V _{CE0}	I _C =-1.0mA I _B =0	-25			V
V _{EBO}	I _E =-10 μ A I _C =0	-6.0			V
I _{CB0}	V _{CB} =-20V I _E =0			-0.1	μ A
I _{EBO}	V _{EB} =-4.0V I _C =0			-0.1	μ A
h _{FE(1)}	V _{CE} =-2.0V I _C =-100mA	100		560	
h _{FE(2)}	V _{CE} =-2.0V I _C =-1.5A(pulse)	65	130		
V _{CE(sat)}	I _C =-1.5A I _B =-75mA(pulse)		-0.35	-0.6	V
V _{BE(sat)}	I _C =-1.5A I _B =-75mA		-0.85	-1.2	V
f _T	V _{CE} =-10V I _C =-50mA		150		MHz
C _{ob}	V _{CB} =-10V f=1.0MHz		32		pF

h_{FE(1)}分档/h_{FE(1)} Classifications: R:100~200 S:140~280 T:200~400 U:280~560



2SB926 (3CG926)

